查询2SC1615供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

T-27-07

2SC1615 2SC4036

三重拡散プレーナ形 NPN シリコントランジスタ
高耐圧電圧増幅用/High Voltage Amp.
Triple Diffused Planar NPN Silicon Transistors

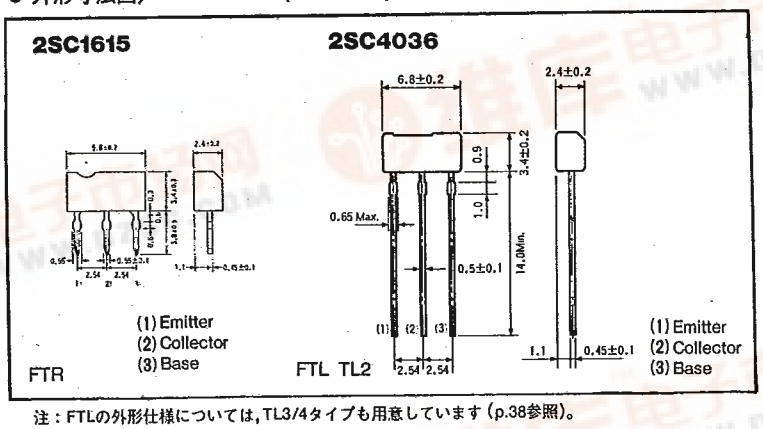
● 特長

1) V_{CER}=210Vと高耐圧である。
2) 三重拡散プレーナ形で，信頼性が高い。

● Features

1) High breakdown voltage: V_{CER}=210V.
2) This triple-diffused planar transistor assures high reliability.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



注：FTLの外形仕様については，TL3/4タイプも用意しています（p.38参照）。

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	210	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}	210	V (R_{BE}=10kΩ)
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	30	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
接合部温度	Tj	125	℃
保存温度範囲	Tstg	−55～125	℃

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CER}	210	—	—	V	I_C=100μA, R_{BE}=10kΩ
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	210	—	—	V	I_C=50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E=50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	1	μA	V_{CB}=150V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	1	μA	V_{EB}=4.5V
直流電流増幅率	h_{FE}	56	—	270	—	V_{CE}/ I_C=3V/5mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1	V	I_C/ I_B=2mA/0.2mA
利得帯域幅積	f_T	—	60	—	MHz	V_{CE}=5V, I_E=−2mA
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	6	—	pF	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	N	P	Q
h_{FE}	56～120	82～180	120～270

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記　号		C1	TL2	TL3
		基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SC1615	N		○	○	—	—
	PQ		◎	○	—	—
2SC4036	NPQ		—	—	○	○

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

T-27-07

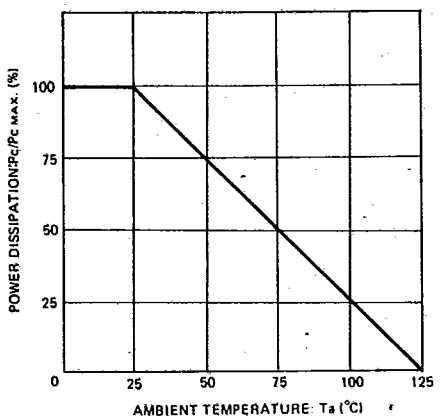


Fig.1 電力軽減曲線

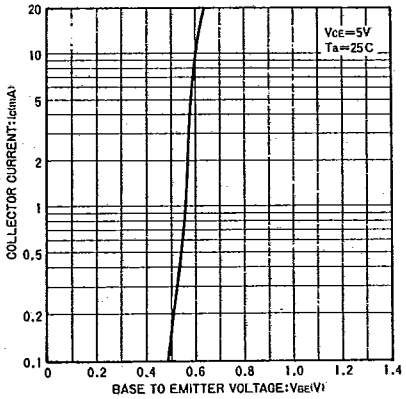


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

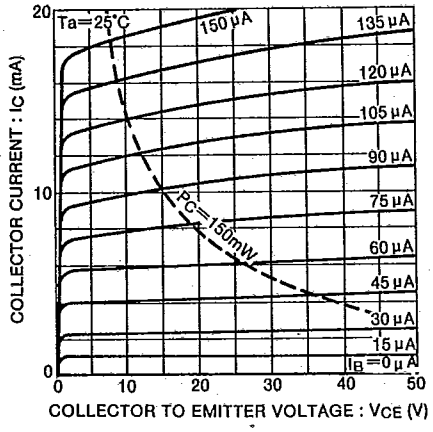


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

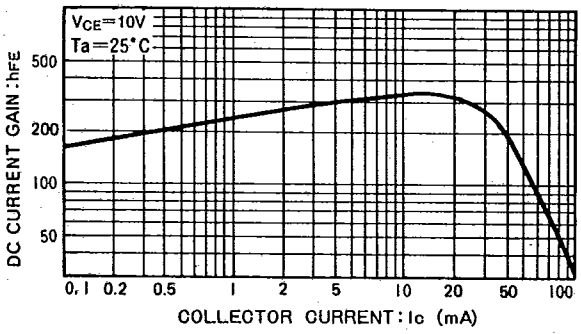


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

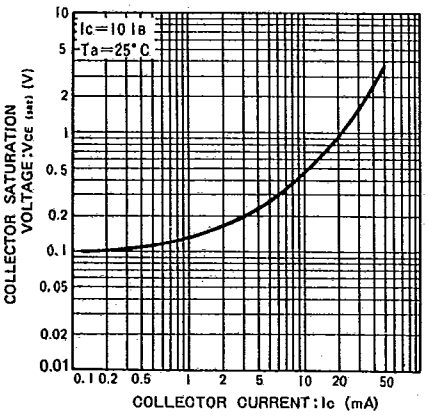


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

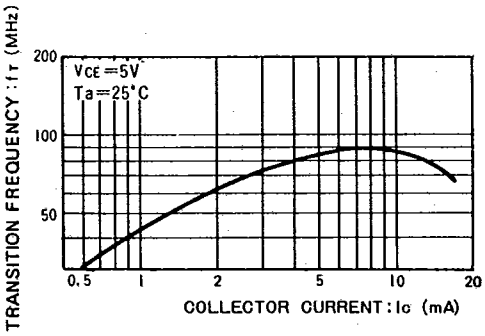


Fig.6 利得帯域幅積—コレクタ電流特性

T-27-07

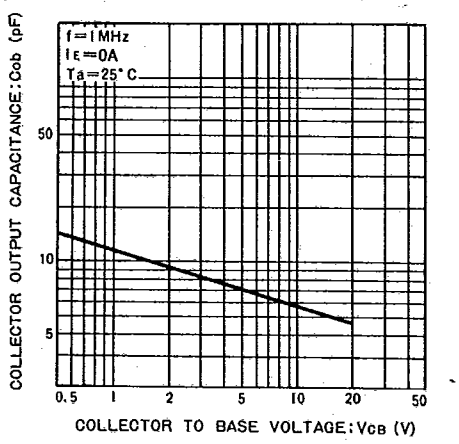


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ·ベース電圧特性

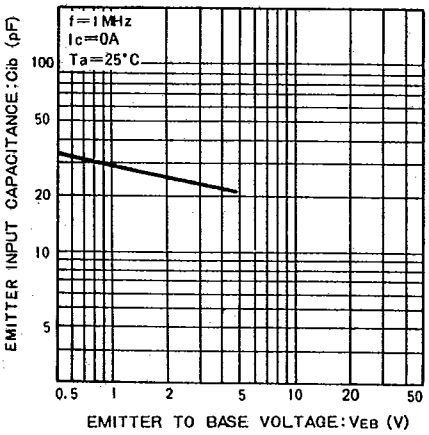


Fig.8 エミッタ入力容量—エミッタ·ベース電圧特性